

Probe Polish (以下、クリーニング基板)は、プローブチップに付着したゴミを取除くように作られています。ポリマー層に含まれている研磨剤が堆積したゴミを取除き、プローブチップおよびコンタクト面を軽く研磨します。このとき研磨作用によりプローブチップが変形することはありません。Probe Polish は-50℃～+200℃の温度範囲で使用することができます。



## クリーニングの頻度と回数

クリーニング頻度は使用される環境等により異なりますが、10コンタクト(ex.半田ボールへのプロービング)から4000コンタクト(ex.テスト前に洗浄されたウェーハへのプロービング)ごとに必要となります。

クリーニングを行う際は100umのオーバードライブで位置を変えながら10回程度押し当てます。(10回で不十分な場合は回数を増やしてください。)

## クリーニング手順

**\*注意:ポリマー表面に指紋等を付けない為にラテックス製手袋をして取り扱ってください。**

1. ラテックス製手袋をしてAuxチャックにセラミック面を下にして置きます。
2. バキュームをONにして吸着します。
3. 表面の保護テープを剥がします。
4. 顕微鏡で表面を観察し、ゴミの無いきれいな部分を探します。プローブをきれいな部分にコンタクトさせます。コンタクトはクリーニング基板表面の凹みで確認することができます。(右上 写真参照)
5. ポジショナーのZ軸目盛りで「100um」のオーバードライブをかけます。
6. チャックを下げる、またはZレバーを上げてプローブをProbePolish から離し、プローブチップの径の2倍以上XY 方向に移動させ、再びコンタクトさせます。
7. 移動とコンタクトを10回程度繰り返します。



## 保守

定期的にクリーニング基板表面の状態を観察し、ゴミや破れ等のダメージが無いことを確認してください。ダメージがひどい場合は使用を中止してください。

ポリマー層表面に軽く付着したゴミはIPA(イソプロピル・アルコール)を垂らし、ゴミの出ない布で一方方向に拭くことで取除けます。IPA 使用後は1～2時間乾燥させ、完全にIPA を蒸発させます。(可能であれば24時間放置してください。)

表面に刺さってしまったゴミ(アルミの削りかす等)は細い天然素材のブラシで取除くことができます。



## プローブクリーニング基板断面図

### Probe Polish (PN 134-209)

Normal Stack Height =  $34.1 \pm 0.5\text{mil}$  ( $866 \pm 13 \mu\text{m}$ )

